# 特許協力条約

1.7 1.1 1.00	- F
発信人 日本国特許庁(国際予備審査機関)	JUN. 29. 2005
出顧人代理人	-2 25. 2003
岡本宜喜	\@ <sub>0</sub> ,
	₩aon Me
82	
あて名	国際予備審査請求書の
₹ 577 - 0066	
日本国大阪府東大阪市高井田本通7-7-19昌利ビル安田	受理通知書
岡本特許事務所内	
	(法施行規則第54条第1項)
	[PCT規則59.3(e)及び61.1(b)第1文、 実施細則601(a)]
	741211111
	発送日(日,月,年)
	28.06.2005
出願人又は代理人の書類記号	1
P37427-P0	雷 鄭 办 通 知
国際出願番号 国際出願日(日.	重 要 な 通 知 月、年) 優先日(日、月、年)
PCT/ JP2005 / 003136 25.	02.2005 27.02.2004
出願人(氏名又は名称)	a and a management of a contract
松下電器產業株式会社	
14 1 Burne XVXXII	
1. 国際予備審査機関は、国際出顧の国際予備審査請求書を次の	日に受理したことを週別する。
03 日 06 月 2005 4	<u> </u>
2、この受理の日は次に示す日である。	
<u> </u>	
✓ 管轄する国際予備審査機関が国際予備審査請求書 (PCT規則61.1(b))	を受理した日
(PC1)9299 01.1(0/)	
管轄する国際予備審査機関に代わって国際予備審	<b>を請求書を受理した日</b>
(PCT規則59.3(e))	
国際予備審査請求書の手続補完書を管轄する国際	予備審査機関が受理した日
3. (注意) 受理の日は、優先日から19箇月が経過して	いる。
したがって、官庁によっては国際予備審査請求が	国内段階移行時期を優先日から30月(これより遅い
期限を規定する官庁もある)までに延長する効果は	なく(PCT第39条(1))、国内段階移行の手続
は、優先日から20月(これより遅い期限を規定する しかし、官庁によっては、国際予備審査請求の有	o E JT もめる)以内に行われなりればなっない。 無に関わらず 3 0 月(これより遅い期限を規定する官
庁もある)の期限が適用される場合がある。	
様式PCT/IB/301の付属書類を参照すること。 適用される期限の詳細については、PCT出願人	の手引、第II巻、国内段階およびWIPOインターネ
ットサイトを参照すること。	7 711 371 21 21113 311
「動业する場合」 この通知け 紫鮮 FAV	又は口頭により次の日に行った連絡を確認するためのも
のである。	人は口頭により入の目に行うた足器を強起するためのも
4. 上記の3に該当する場合に限り、この通知書の写しを国際事	務局に送付した。
1	ある職員
日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許 庁長官

# 特許協力条約に基づく国際出願 国際予備審査請求書

第 Ⅱ 章

出順人は、次の国際出職が特許協力条約に従って国際予備審査の対象とされることを請求する。

	国際予備審査	機関記入欄		
国際予備審査機関の確認		請求書の受理の日		
第1欄 国際出願の表示			出版人又は代理人の書類記号	
以際出版番号	河梨出版日(日、月、年)		出版人又は代現人の書類記号 P37427-P0 優先日(最先のもの) (日、月、年)	
PCT/JP2005/003136	25.02.200	5	27.02.2004	
発明の名称 半導体メモリ装置				
第1欄 出順人				
氏名(名称)及びあて名: (姓、名の順に記載:法人 名も記載)	は公式の完全な名称を記載	! : あて名は郵便番号及び回	電話番号: 06-6949-4524	
松下電器産業株式会社			ファクシミリ番号:	
MATSUSHITA ELECTRIC INC				
〒571-8501日本国大阪府門真				
1006, Oaza Kadoma, Kadoma	shi, Osaka 5/1	-8501 JAPAN	出版人登録番号:	
<sup>図版(開名):</sup> 日本国JAPAN		<sup>住所(図名):</sup> 日本国	JAPAN	
氏名(名称)及びあて名:(姓、名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記載:あて名は郵便番号及び図名も記載)				
中西 雅浩 NAKANISHI Masahiro				
回路 (周名) :		住所 (規名):		
氏名(名称)及びあて名:(使、名の都に起席:法人は公式の完全な名称を尼賓:あて名は長便書号及び図名も必む 泉 智紹 IZUMI Tomoaki				
<b>闽南(周名)</b> :		住所 (間名):		
✓ その他の出組人が収算に記載されている。				

	国際出願番号
2	N
第14欄の続き 出順人	
この第日線の続きを使用しないときは、この用紙を国際予備審査請求者に含める	burk.
氏名(名称)及びあて名: (姓、名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記。	
笠原 哲志 KASAHARA Tetsushi	
EN LIE TOTAL TOTAL	
	Dec (att)
国籍 (国名) :	住所(国名):
氏名(名称)及びあて名: (姓、名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記述	W:あて名は郵便器号及び国名も記載)
田村 和明 TAMURA Kazuaki	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	住所 (図名):
料核( <i>(1945)</i> ・	tem (MA) :
5名(名称)及びあて名:(姓、名の欄に配載:法人は公式の完全な名称を記む	W; あて名は郵便器号及び国名も記載)
松野 公則 MATSUNO Kiminori	
<b>国語 (個名)</b> :	住所 ([[[名]]):
SAL CEPTO V	Tank (Marry)
天名(名称)及びあて名:(姓、名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記れ	援:あて名は郵便番号及び開名も記載)
井上 学 INOUE Manabu	
頭陰 (原名):	(hat (had) )
SIR (192):	住所 ( <b>旧名</b> ):
その他の出願人が他の続葉に記載されている。	

	国際出願番号		
3 **			
Д			
第田欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名			
下記に記載された名は、	、今側新たに選任された者である。		
氏名(名称)及びあて名:(姓、名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記載:あて名は鄭鏡語号及び国 名も記載)	電話番号: 06-6782-6905		
8436弁理士 岡本宜喜 OKAMOTO Yoshiki	ファクシミリ番号:		
〒577-0066日本国大阪府東大阪市高井田本通7丁目7番19号 昌利ビル 安田岡本特許事務所内	06-6782-9101		
自列こル 女田岡本付計事務別内 c/o YASUDA & OKAMOTO, Shori Building, 7-7-19,	加入超低而号:		
Takaida-hondori, Higashi-Osaka shi, Osaka 577-0066 JAPAN	代理人登録委号: 100084364		
週知のためのあて名: 代別人又は共通の代表者が選任されておらず、上紀枠内に特に通知が送付されるあて名を記載して	いる場合は、レ印を付す。		
第Ⅳ欄 国際予備審査に対する基本事項			
議正に関する記念:・・  1. 田風人は、次のものを基礎として国際予報書意を開始することを希望する。	利達も含む)を基礎とすること。 5こと。 5こと。 2り前されたものとみなして開始することを希望する。 物することを希望する。 図飾することを明示的に希望する。 図解の図問題を経過に不確確的知識され、		
国際調査のために提出した翻釈文の言語である。			
国際出版の公開の言語である。			
国際予備審査の目的のために提出した構訳文の言語である。			
第V欄 園の選択			
この様式を用いてきれた国際予備審査の請求は、指定され、かつPCT新1章に拘束される全ての締約回を選択する国際予備審査の請求となる。			

	国際出版番号		
<b>4</b> g			
第 VI 相關 19.6 合相關			
この国際予備審査請求書には、国際予備審査のために、類N側に記載する言語による 下記の遺析が指付されている。 1. 国際出議の研究と、	国際学術報達機関 記入相間 受 新 * * 受 新		
特別権力条約前 1 9条の規定に基づく福正書 (文は、要求された衛台建即270 のでし、 教 松 4 特別権力条約前 1 9条の規定に基づく説明書 (文は、要求された場合は無深文)の写し、			
	を形式による配列表 を形式による配列表に関連するテーブル		
國際予備審查機関記入欄 ——			
上版 Nex 3 * Vill 4年、正にも交 (2) おこ / へ 144   1. 国際子指寄査請求者の実際の受視の日			
2. 規則 60.1(6)の規定による国際予備審査請求責の受理の日の訂正後の日付			
□ 出版人に追加した。	認められている規則 54 の 2.1(a)の開限 ちの受理。 場の経過後の国際予備審査請求者の受理		
国際予備書数請求書の国際予備審査機関からの受領の日:			

様式PCT/1PEA/401 (最終用紙) (2004年1月版)

### 手数料計算用紙

### 国際予備審査請求書の附属書

	国際予備審查機閱記入欄 ——
欧原出戦番号 PCT/JP2005/003136	
出版人又は代理人の書類記号	
P37427-P0	国際予備審査機関の日付印
松下電器産業株式会社	
所定の手数料の計算	
1. 特許協力条約に基づく国際計算等に関する法律(国内法) 第18条第1項第4号の規定による手数料 (予鑑審資訊來料) (注1)	36,000 FJ P
2、取級手效料 (注2)	17,600 PJ H
3. 所定の手数料の合計	
P及びHに記入した金額を加奪し、合計額を合計に記入 	53,600 H
(注1) 注前18条第1項第4号の規定による手数料については、 (注2) 東接手数料については、国際手編基理機である日本国际 展り込みを提明する資源を提出することにより動付しなけ	行子の長官が告示する国際事務局の口座への

### 手 続 補 正 書(法第11条の規定による補正)

### 特許庁審查官 丹治 彰 殿

国際出願の表示 PCT/JP2005/003136

2. 出願人

名称 松下電器産業株式会社

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

あて名 〒571-8501 日本国大阪府門真市大字門真 1006 番地 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka

571-8501 Japan

国籍 日本国 Japan

住所 日本国 Japan

3. 代理人

氏名 弁理士 岡本 宜喜

OKAMOTO Yoshiki

あて名 〒577-0066 日本国大阪府東大阪市高井田本通 7-7-19

昌利ビル 安田岡本特許事務所内

c/o YASUDA & OKAMOTO, Shori Building,

7-7-19, Takaidahondori,

Higashi-Osaka shi, Osaka 577-0066 Japan

国籍 日本国 Japan

住所 日本国 Japan

4. 補正の対象

請求の範囲

5. 補正の内容

請求の範囲第13頁第1項の「前記主記憶メモリに対して第2の記憶容 量単位毎に設けられ、データ」を「前記第1の記憶容量より小さい第2の 記憶容量単位毎に設けられ、対応する前記主記憶メモリに対してデータ

- の」に補正する。第4項を削除する。
- 6. 添付書類の目録 請求項を記載した書面(請求の範囲第13頁)

### 請求の節囲

[1] (補正後)第1の記憶容量のデータ領域と管理領域から成る複数の記憶容量単位 で構成された記憶領域を有する不揮発性の主記億メモリと、

前記主記憶メモリのアドレス管理情報を記憶するアドレス管理情報記憶部と、

前記第1の記憶容量より小さい第2の記憶容量単位毎に設けられ、対応する前記 主記憶メモリに対してデータの書き込みが完了したときに立てられる書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記憶する不揮発性の制御メモリと、

ホストからデーク読み書き指示に応じて前記主記憶メモリに対してデータの読み書き制御を行うと共に、前記アドレス管理情報記憶部及び前記制御メモリの更新制御を行う制御部と、を備えた半導体メモリ装置。

- [2] 前配第2の記憶容量単位はクラスタサイズであり、 前記制御メモリは、ホストのファイルシステムで規定されたクラスタサイズ毎に1ビット 以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録する請求項 1記載の半導体メモリ装置。
- [3] 前記第2の記憶容量単位はセクタサイズであり、 前記制御メモリは、ホストのファイルシステムで規定されたセクタサイズ毎に1ビット 以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録する請求項 1記載の半導体メモリ装置。
- [4] (削除)
- (5) 前記制御メモリは、書き込み速度が前記主記憶メモリより速い請求項1記載の半導体メモリ装置。
- [6] 前記制御部は、予め記憶された第2の記憶容量単位に基づき、初期化時もしくは 工場出荷時に、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成する請求項1記載 の半導体メモリ装置。
- [7] 前記制御部は、ホストから転送された第2の記憶容量単位に基づき、初期化時もし

#### PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

### PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

OKAMOTO, Yoshiki

c/o YASUDA & OKAMOTO, Shori Building, 7-7-19, Takaidahondori, Higashi-Osaka shi Osaka

5770066 JAPON

Applicant's or agent's file reference IMPORTANT NOTIFICATION P37427-P0

International application No. PCT/JP05/003136

Date of mailing (day/month/year) 05 May 2005 (05.05.2005)

> International filing date (day/month/year) 25 February 2005 (25.02.2005)

International publication date (day/month/year)

Priority date (day/month/year) 27 February 2004 (27.02.2004)

Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

- 1. By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. (If applicable) The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a), the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 3. (If applicable) An asterisk (\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Country or regional Office Date of receipt Priority date Priority application No. or PCT receiving Office of priority document

27 February 2004 (27.02.2004)

2004-053960

JP

28 April 2005 (28.04.2005)

Authorized officer The International Bureau of WIPO 34. chemin des Colombettes Akremi Taieb 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 90 90 Telephone No. +41 22 338 9415 Facsimile No. +41 22 740 14 35

### PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

OKAMOTO, Yoshiki

c/o YASUDA & OKAMOTO, Shori Building, 7-7-19, Takaidahondori

Higashi-Osaka shi Osaka 5770066

Japan

MAY. 2,2005

Date of mailing (day/month/year) 14 April 2005 (14.04.2005)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference	International application No.
P37427-P0	PCT/JP2005/003136

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. (for all designated States except US) NAKANISHI, Masahiro et al (for US)

International filing date

25 February 2005 (25.02.2005) 27 February 2004 (27.02.2004) Priority date(s) claimed

Date of receipt of the record copy by the International Bureau 10 March 2005 (10.03.2005)

List of designated Offices

AP:BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW

EA: AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM

EP:AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,MC,NL,PL.PT.RO.SE,

SLSK.TR OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National :AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO.CR,CU,CZ,DE,DK,DM, DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,

LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK, SL,SM,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

PETRESKA Gorica

Facsimile No. (41-22) 338.90.90 Telephone No. (41-22) 338 9999

Form PCT/IB/301 (January 2004)

006664655

#### Continuation of Form PCT/IB/301

#### NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

Date of mailing (day/month/year) 14 April 2005 (14.04.2005)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference P37427-P0	International application No. PCT/JP2005/003136

#### ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau. In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

- time limits for entry into the national phase see updated important information (as of April 2002)
- requirements regarding priority documents (if applicable)

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

#### INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated on the cover sheet of this Notification by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by Articles 22 and 39 and the applicable anational laws. In addition, the applicable have too comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry in the national phase.

The applicable time limit for entering the national phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 30 MONTHS from the priority date, not only in respect of any elected Office if a demand for international preliminary examination is flied before the expiration of 19 months from the priority date (see Article 39(1)), but also in respect of any designated Office, in the absence of fitting of such demand, where Article2(1) as modified with effect from 1 April 2002 applies in respect of that designated Office. For further details, see PCT Gazette No. 44/2001 of 1 November 2001, pages 1992.6, 19832 and 19834.a. swell as the PCT Neveletter, October and November 2001 and February 2002 issues.

In practice, time limits other than the 30-month time limit will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain designated or elected Offices. For regular updates on the applicable time limits (20, 21, 30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the PCT Gazette("Section IV" part published on a weekly basis), to the PCT Newsletter (on a monthly basis) and to the relevant National Chapters in Volume II of the PCT Applicant's Guide (the paper version of which is updated usually vora expert and the Internet version of which is updated usually on a weekly basis). Finally, a cumulative table of all applicable time limits for entering the national phase is available from WIPO's Internet site, via links from various pages the site including those of the Gazette, Newsletter and Guide, at http://www.wipo.int/pcterindrinek.html.

Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in the PCT Applicant's Guide, Volume IV. Chapter IV. Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

#### REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filled ("the priority document") to the reciting office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau bette date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau been less stay of the 16-month time film (filled 17.16).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1th).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within the time limit which is reasonable under the circumstances (Bule 17.1(c)).

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit (and all other PCT time limits) is the filling date of the earliest application whose priority is claimed (Article 2(xi)(b)).

### 特許協力条約

PCT

#### 国際調查報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]



出願人又は代理人 の書類記号 P37427-P0	今後の手続きについては、様式PCT/ISA/220 及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP2005/003136	国際出願日(日.月.年)	25.02.	2005	優先日 (日.月.年)	27.02.2004
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社					

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を決施行規則第41条 (PCT18条) の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で \_\_\_2 ページである。

Г この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

- 1. 国際調査報告の基礎
  - a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。
    - □ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った(PCT規則23.1(b))。
- b. 「 この国際出版は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでいる(第1欄参照)。
- 2. 「 請求の範囲の一部の調査ができない (第Ⅱ欄参照)。
- ご 発明の単一性が欠如している(第Ⅲ欄参照)。
- ☑ 出願人が提出したものを承認する。
  - □ 次に示すように国際調査機関が作成した。
- 5. 要約は ☑ 出願人が提出したものを承認する。
  - 「 第IV欄に示されているように、法施行規則第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により 国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ
  - の国際調査機関に意見を提出することができる。
- 6. 図面に関して

4. 発明の名称は

- a. 要約書とともに公表される図は、
  - 第 4 図とする。 ♥ 出願人が示したとおりである。
    - 「 出願人は図を示さなかったので、国際調査機関が選択した。
    - 本図は発明の特徴を一層よく表しているので、国際調査機関が選択した。
- b. 厂 要約とともに公表される図はない。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.CL7 G06F12/16

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int C17 G06F12/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 日本国実用新家登録公報

1971-2005年 1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

<ul><li>C. 関連する</li><li>引用文献の</li><li>カテゴリー*</li></ul>	と認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Х	JP 2001-5928 A(日立マクセル株式会社)2001.01.12, 全文,全図(ファミリーなし)	1~13
A	JP 2003-15929 A (松下電器産業株式会社) 2003.01.17, 全文, 全図 & US 2003-189860 AI & EP 1403771 AI & WO 03-3219 AI & CA 2420986 A & CN 1465012 T	1-13

#### C欄の続きにも文献が列挙されている。

ド パテントファミリーに関する別紙を参照。

\* 引用文献のカテゴリー

- もの
- 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す
- る文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出額と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
  - 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
  - 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
  - 「&」同一パテントファミリー文献

の日の後に公表された文献

国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 28, 4, 2005 06.04.2005 5 N 8320 特許庁審査官 (権限のある職員) 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 丹治 彰 郵便番号100~8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3586 東京都千代田区常が関三丁目4番3号

### 特許協力条約

#### 発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

利ビル安田岡本特許事務所内

**什理人** 岡本宜喜 糍

日本国大阪府東大阪市高井田本通7-7-19昌



PCT

国際調査報告及び国際調査機関の見解書 又は国際調査報告を作成しない旨の決定 の送付の通知書 (法施行規則第 41 条)

[PCT規則44.1] 卷送日 26 4 2005 (日,月,年)

出願人又は代理人

〒 577-0066

あて名

の事類記号 P37427-P0 今後の手続きについては、下記1及び4を参照。

国際出願番号 PCT/IP2005/003136

(日.月.年) 25. 02. 2005

出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社

1. ▼ 国際調査報告及び国際調査機関の見解書が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通 知する。

自認用額目

PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出

出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる (PCT規則 46 参照)。

いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。

どこへ 直接次の場所へ

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22)740, 14, 35 詳細な手続については、添付用紙の備考を参照すること。

- 2. 厂 国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項 (PCT17条(2)(a)) の規定による国際調査報告を作成 しない旨の決定及び国際調査機関の見解書をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 記の点を通知する。

異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申し立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁 へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。

当該毘護についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。

4 会後の手続・出版人は次の点に注意すること。

優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むと きは、国際出願又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2,1及び90の2,3にそれぞれ規定されているように、 国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。

いくつかの指定官庁については、出願人が国内段階の開始を優先日から30月まで(官庁によってはさらに遅くま で) 延期することを望むときは、優先日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。そ うでなければ、出願人はそれらの指定官庁に対して優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定の手続を

敗らなければならない。

その他の指定官庁については、19月以内に国際予備審査の請求書が提出されない場合にも、30月の(あるいは さらに遅い) 期限が適用される。

様式PCT/IB/301の付属書類を参照。個々の指定官庁で適用される期限の詳細については、PCT出願人の手引、第 II券 国内段階およびWIPOインターネットサイトを参照。

5 N 8320 権限のある職員 名称及びあて名 日本国特許庁 (ISA/JP) 特許庁長官 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3586 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

### 特許協力条約

発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

ビル安田岡本特許事務所内

JE ILI JC	M -4-122-14 0 ( ) 3	(ESINGATE MOSA)	
代理人			
岡本	宜喜		
			揺
			松
あて名			
〒577-			
日本	国大阪府市大陆	阪市高井田本涌7-7-19昌利	



PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]

発送日 (日,月,年)

28. A. 30 M

(日.月.年) 27.02,2004

出願人又は代理人

の書類記号 P37427-P0

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

優先日

国際出願番号 PCT/JP2005/003136 (日.月.年) 25.02.2005

国際特許分類 (1 P C) Int.Cl. G06F12/16

出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社

- 1. この見解書は次の内容を含む。
  - ▽ 第1欄 見解の基礎
  - 第1個 優先権
  - □ 第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
  - □ 第IV欄 発明の単一性の欠如
  - ▽ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 それを専付けるための文献及び疑問。
  - 「 第VI欄 ある種の引用文献
  - 「 第VI欄 国際出層の不備
  - 「 第W機 国際出版に対する意見
- 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出顧人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 際予備審査機関がPCT規 66.1 の 26.0 の規定に基づいて国際調査機関の見解毒と同語予備審査機関の見解毒とみなさ ない旨を国際事務院に通知していた場合を除いて、この見解は国際予備審表機関の扱り解析とみなされた ない旨を国際事務院に通知していた場合を除いて、この見解計国際予備審表機関の扱りの異解書とみなされた。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は後先日から22月のうちいずれか速、満下する別限が距過するまでに、出版人は国際予備審査機関に、適当な場合は極正書とともに、条手繋を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

06.04.2005

名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 77石 彩

特許庁審査官 (権限のある職員) 丹治 彰

電話番号 03-3581-1101 内線 3586

5N 8320

#### 第1欄 見解の基礎

1	この貝解準け	下記に示す場合を除くほか	、国際出版の言語を基礎として作成された。

 この国際出版で関示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。

配列表に関連するテーブル

b. フォーマット 厂 書面

コンピュータ読み取り可能な形式

□ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. 「さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを使出した場合に、出願後と集出した配列表しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見:

第V欄	進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則 43 の 2.1(a)(i)に定める 取付る文献及び説明	見解、

### 1. 見解

2011				
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	2, 3, 6, 7, 10-13 1, 4, 5, 8, 9	) * (	_ 有
進歩性(18)	請求の範囲 請求の範囲	1-13		_ 有
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-13		_ 有

#### 2. 文献及び説明

請求の範囲 1-13

JP 2001-5928 A (日立マクセル株式会社) 2001.01.12, 全文、全図 (ファミリーなし)

請求の範囲1,4,5,8,9に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性、進歩性を有さない。

文献 1 には、電気的に書き込みが可能で、かつ所定の単位でデータを記憶する不揮発性のデータ記憶部が設けられる I C カードにおいて、上位装置からデータアクセスのために指定される論理プロックアドレスを、複数のフラッシュメモリから構成されるデータ記憶部のメモリ空間上の実際のアドレスである実プロックアドレスに変換するための第 1 のテーブルと、実プロックアドレス内のデータの状態を管理するフラグ情報を格納するための第 2 のテーブルとを格納する不揮発性メモリは、アクセスがEEPROMやフラッシュメモリに比べて高速であり、パイト単位でデータの書族が可能なF R AMや、電池でベックアップされた S R AMを用いること、そして、所定プロックのデータのデータ記憶部への転送が終了すると、第 2 のメモリのフラグ情報を「0 0 日」に設定されること、電源瞬柄がフラッシュメモリの書き込み処理中に発生した場合、I C カードの電源投入後の初期化処理において、書き込み中フラグの状態を確認と、フラグがセットされている場合には、前回の処理でデータ書き込み中の処理中所が起こったと判断することが開示されている。

上記文献1の「データ記憶部」、「第1のテーブル」、フラグ情報を格納するための 第2のテーブルを格納する「不揮発性メモリ」、「マイコン」は、それぞれ、請求の範 囲1の「不揮発性の主記憶メモリ」、「アドレス管理情報記憶部」、「不揮発性の制御メ モリ」、「制御部」に対応する。

そして、請求の範囲4,5,8,9に関しても、記憶容量単位を物理ブロックサイズとすること、制御メモリの書き込み速度が主記憶メモリより速いこと、アドレス変像テーブルを有することも開示されていることも、上記の通り文献1に開示されている。

#### 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

#### 第 V 欄の続き

請求の範囲 2, 3, 6, 7, 10-13 に係る発明は、国際調査報告で引用された 文献 1 から進歩性を有さない。

書き込み完了フラグを設ける記憶容量単位を、いかにするかは、当業者の設計的事項にすぎないものであって、その単位としてクラスタサイズ、セクタサイズを採用することに格別の技術的困難性が存するものとも認められない。

また、制御部が、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成する際に、予 め記憶された第2の記憶容量単位、あるいはホストから転送された第2の記憶容量単位とすることは、当業者の設計的事項にすぎない。

また、制御メモリとして、強誘電体メモリ、磁性記録式随時書き込み読み出しメモリ、オボニックユニファイドメモリ、レジスタンスRAMを採用することも、当業者の設計的事項にすぎない。

発信人 日本国特許庁(国際調査機関)



11 007 1 42 708 1			DAR	OKAR
出願人代理人 岡本宜喜		調	査用写しの	
あて名 〒 577 - 0066	殿	,	受理の通知	
日本国大阪府東大阪市高井田本通 7 - 7 - 1 岡本特許事務所内	9 昌利ビル安田			
		[PCT規則	25. 1)	
		発送日(日.	月. 年) 08.03.2005	
出額人又は代理人の書類記号 P37427-P0			重 要 な 通 知	
国際出願番号	国際出願日(日.,	月. 年)	優先日(日.月.年)	
PCT/ JP2005 / 003136	25.02	2.2005	27.02.2004	
出願人(氏名又は名称)				
松下電器産業株式会社				

国際調査機関と受理官庁が同一の機関でない場合、
 国際出額の調査用写しを国際調査機関が下記の日に受理したので通知する。

国際調査機関と受理官庁が同一の機関である場合、

国際出願の調査用写しを下記の日に受理したので通知する。

<u>08 日 03 月 2005 年</u> (受理の日)

- 調査用の写しには、コンピューター読取りが可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表若しくは 配列表に関連するテーブルが条付されている。
- 3. 国際調査報告及び見解書の作成期間 国際調査報告及び見解書の作成期間は、上記受理の日から3月又は優先日から9月のいずれか選く調丁する期間である。
- 4. この通知書の写しは、国際事務局及び上記第1項の第1文が適用される場合には受理官庁に送付した。

国際調査機関の名称及びあて名

権限のある職員

日本国特許庁 (ISA/JP)

特許庁長官

郵便番号 100-8915 電話番号 03-3592-1308 日本国東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

様式PCT/1SA/202 (2004年1月)

### 受領書

平成17年 2月25日 特許庁長官

識別番号

100084364

氏名(名称)

岡本 官喜

様

提出日

平成17年 2月25日

以下の書類を受領しました。

項番 書類名 整理番号 受付番号 出願番号通知(事件の表示)

1 国際出願 P37427-P0 50500336552 PCT/JP2005/ 3136

以上

### 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出版番号	
0-2	国際出版日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出顧顧書 は、	
0-4-1	右記によって作成された。	JP0-PAS 0322
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許協力条約 に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	P37427-P0
1	発明の名称	半導体メモリ装置
II	出順人	
11-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
H-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
11-4ja	名称	松下電器産業株式会社
II-4en	Name:	MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD.
II-5ja	あて名	5718501
Ii-5en	Address:	日本国 大阪府門真市大字門真1006番地 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 5718501 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国リ
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	常話番号	06-6949-4524
11-9	ファクシミリ番号	06-6949-4548
III-1	その他の出願人又は発明者	00-0343-4340
III-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-1-2	右の指定国についての出額人である。	米国のみ (US only)
III-1-4ja	氏名(姓名)	中西雅浩
III-1~4er	Name (LAST, First):	NAKANISHI Masahiro
III-1-5ja		
III-1-5er	Address:	
III-1-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-1-7	住所(国名)	

### 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

111-2	その他の出願人又は発明者	
111-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-2-4ja	氏名(姓名)	泉智紹
	Name (LAST, First):	IZUMI Tomoaki
III-2-5ja		
III-2-5en	Address; 国籍(国名)	
		日本国 JP
111-2-7	住所(图名)	
III-3 III-3-1	その他の出版人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-3-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-3-4ja	氏名(姓名)	笠原哲志
	Name (LAST, First):	KASAHARA Tetsushi
III-3-5ja	あて名 Address:	
	Address:  国籍(国名)	n
		日本国 JP
III-3-7	住所(国名) その他の出願人又は発明者	
III~4~1	この欄に記載した者は	ULTER 1 TO THE SECOND ST TO A ST
	右の指定国についての出願人である。	出願人及び発明者である (applicant and inventor)  米国のみ (US only)
111-4-4ja	氏名(姓名)	田村和明
III-4-4en	Name (LAST, First):	TAMURA Kazuaki
III-4-5ja	あて名	THE TOTAL CONT.
III-4-5en	Address:	
III-4-6	国籍(国名)	日本国 JP
IH-4-7	住所(国名)	
HI-5	その他の出願人又は発明者	
111-5-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-5-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-5-4ja	氏名(姓名)	松野公則
III-5-4en	Name (LAST, First):	MATSUNO Kiminori
111-5-5ja	あて名	
III-5-5en		
III~5~6	国籍(国名)	日本国 』
	住所(国名)	
III-6	その他の出願人又は発明者	
	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
	氏名(姓名)	井上学
	Name (LAST, First):	INOUE Manabu
III-6-5ja		
III-6-5en	Address: 国籍(国名)	
		日本国 JP
111-6-7	住所(国名)	

# 特許協力条約に基づく国際出願願書 紙面による等し(注意:電子データが原本となります)

	紙面によ	5写し(注意:電子データが原本となります)		
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名	Γ		
	下記の者は国際機関において右記のごとく 出顧人のために行動する。	代理人 (agent)		
IV-1-1 ja	氏名(姓名)	岡本官喜		
IV-1-1er	Name (LAST, First):	OKAMOTO Yoshiki		
[V-1-2ja	あて名	5770066		
		日本国 大阪府東大阪市高井田本通	7-7-19昌利ビル安田	
11/-1-9	Address:	岡本特許事務所内	1 0 11 (1 3 3 40	
14 1 26	Num 635.	c/o YASUDA & OKAMOTO, Shori Building, 7-7-19, Takaidahondori, Higashi-Osaka shi Osaka 5770066		
IV-1-3	報話番号	Japan		
	現の面です	06-6782-6905		
		06-6782-9101		
IV-1-6	代理人登録番号	100084364		
V V-1	国の指定 この顕書を用いてされた国際出順は、規則			
V-1	この報告を持た。国際出版の時点で拘束される全てのPCT締約国を指定し、取得しうるあらめる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と関内特許の両方を求める国際出版となる。			
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張			
VI-1-1	出順日	2004年 02月 27日 (27.02.2004)		
VI-1-2	出顧番号	2004-053960		
Vi-1-3	国名	日本国 JP		
V1-2	優先権証明書送付の請求			
	上記の先の出願のうち、右記の番号のもの については、出願書類の認証療本を作成 し国際事務局へ送付することを、受理官庁 に対して請求している。	VI-1		
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)		
VIII	申立て	申立て数		
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	_		
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日に おける出願人の資格に関する申立て	-		
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日 における出願人の資格に関する申立て	-		
VIII~4	発明者である旨の申立て(米国を指定国と する場合)	-		
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例 外に関する単立で	_		
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ	
EX-1	順書(申立てを含む)	4	<u> </u>	
IX-2	明細書	12	<u> </u>	
IX-3	請求の範囲	2	✓	
IX~4	要約	1	<b>✓</b>	
1X~5	図面	10	<b>✓</b>	
1X-7	合計	29		

### 特許協力条約に基づく国際出願願書

※ 15 紙面による写し (注意:電子データが原本となります)

	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数科計算用紙	_	1
IX-11	包括委任状の写し	-	7
IX-17	PCT-SAFE 電子出順	_	_
IX-19	要約書とともに提示する図の番号	4	
IX~20	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	/100084364/	
X-1-1	氏名(姓名)	岡本宜喜	
X-1-2	署名者の氏名	F-11-2-B	
X-1-3	権限		

### 受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受 理の日	
10-2	<b>凶而</b>	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出版として提出された書類を補完する 書類又は図面であってその後期間内に提 出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補 完の期間内の受理の日	
10~5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関 に調査用写しを送付していない	

#### 国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	

### PCT手数料計算用紙(顯書付属書)

### 無面による写し(注意:電子データが原本となります) 【この用紙は、国際出願の一部を構成せず、国際出願の用紙の枚数に算入しない】

0	受理官庁紀入欄				
0-1	国際出願番号				
0-2	受理官庁の日付印				
	1			***************************************	
0~4	様式-PCT/RO/101(付属書)	_			
	このPCT手数科計算用紙は、				
0-4-1	右記によって作成された。		JPO-PAS		
			0322		
0-9	出願人又は代理人の書類記号		P37427-P0		
2	出順人		松下電器産業株式	会社	
12	所定の手数料の計算		金額/係数	小計 (JPY)	
12~1	送付手数料	T	4	13000	
12-2	調査手数料	s	\$	97000	
12-3	国際出願手数科				
	(最初の30枚まで)	il	123200		
12~4	30枚を越える用紙の枚数		0		
12-5	用紙1枚の手散料	(X)	0		
12-6	合計の手数料	i2	0		
12-7	i1 + i2 =	i	123200		
12-12	fully electronic filing fee reduction	R	-26400		
12-13	国際出願手数料の合計 (i-R)	I	\$	96800	
12-17	納付するべき手数料の合計 (T+S+I+P)		₽	206800	
12~19	支払方法		送付手数料: 予納	口座引き落としの	<b>亚</b> 訳
				口座引き落としの	
				銀行口座への振込	
12-20	予納口座			2417-12 +7322	
	受理官庁		日本国特許庁 (RO	/.IP)	
12-20-1	上記手数料合計額の請求に対する承認		/	7 01 7	
12-21	予納口座番号		044336		
12-22	日付		2005年 02月 25日	(25, 02, 2005)	
12-23	紀名押印	_			

1

半導体メモリ装置

技術分野

- [0001] 本発明は、半導体を使用したメモリ装置に関し、詳しくは主記憶用の半導体メモリとして不揮発性のメモリを用いた半導体メモリ装置に関するものである。 背景技術
- [0002] 半導体メモリ装置の中で、SDメモリカードやコンパクトフラッシュ(登録商標)等のメ モリカードは小型サイズであるので、デジタルスチルカメラ等のポータブル機器の着 脱可能なメモリ装置として実用に供されている。
- [0003] 実用に供されている半導体メモリ装置は、通常内部に不揮発性メモリであるフラッシュメモリと、その制御回路であるコントローラLSIが内蔵されている。近年、半導体メモリ装置における大容量化のニーズの高まりに伴い、不揮発性メモリチップ自体も大容量が進みつつある。また実装技術の進歩により半導体メモリ装置に実装される不揮発性メモリのチップ数も増加し、半導体メモリ装置としてのメモリ空間として1GBを超えるものが実用化されている。
- [0004] フラッシュメモリにおけるアドレス管理情報の管理方法として、大別して2通りの方法 がある。第1の方法は、メモリカードのメモリ領域全体、あるいはメモリ領域全体を所定 数に分割した領域毎に、その領域全体に対応するアドレス管理情報をまとめて所定 ブロックに記憶させる方法である。このアドレス管理方法は集中型アドレス管理方法と 呼ばれる。
- [0005] 第2の方法は、物理プロックを構成している所定ページ(セクタ)にデータを書き込む際に、管理情報、即ち当該データが有効であるかどうか等を表すステータス情報や論理アドレスをそのページが含まれる物理プロックの冗長領域に書き込む。そして電源投入時において各物理プロックに分散して書き込まれた管理情報を読み出して、メモリにアドレス管理テーブルを構築する方法である。この方法を分散型アドレス管理方法という。本発明は分散型アドレス管理方法を前提とするものである。
- [0006] 次に分散型アドレス管理方法による半導体メモリ装置の主記憶メモリの一例につい

て説明する。主記憶メモリとして4Gビット、即ち512Mバイトの容量を持つものとする。主記憶メモリ11は図1に示すように、複数の物理ブロック、例えばPB0~PB2047までの2048の物理ブロックによって構成される。各物理ブロックのデータ容量は256kB(バイト)とする。この主記憶メモリは、二値のNANDフラッシュメモリとする。

- [0007] 図2は1つの物理プロックを示した説明図である。この例では各物理プロックはベージ0~ページ127までの128ページから構成される。各ページは、セクタ0~セクタ3までの4セクタのデータ領域と管理領域(MR)とから構成される。1セクタは512Bの容量を有し、各ページは計2048Bのデータ領域を有する。管理領域は64Bの容量を有する。管理領域内にはそのデータの有効や無効を示す状態コード、書き込み完了フラグ、誤り訂正のためのECCコード等が含まれる。ECCコードはそのデータ領域内で1乃至2ビットのエラー訂正機能を有する。この主記憶メモリは二値のNANDフラッシュメモリであるため、ページ単位のみならす、ページ中のセクタのみ、又はセクタの一部の管理領域のみを独立して書き込むことができる。
- [0008] さて、図3は1クラスタ(16kB)分のデータの書き込み又は書き換えを示したタイムチャートである。この例では1つの物理ブロックのページ0~ページ7にデータを書き込む。この書き込み時間T1は例えば数m秒である。そしてページ7の書き込みが完了した直後に、図2のページ7の管理領域MRに書き込み完了フラグを書き込む。この書き込み時間T2は例えば200~300 μ 秒である。又書き換えをする場合には、ページ0~7の書き込みに加えて、他のブロックの既に書かれているデータを新しい物理ブロックにコピーする処理を行う。この書き換え時間をT3とする。この後に有効な各クラスタの最終ページであるページ7、15、・・・127に書き込み完了フラグを書き込む(T2)。
- [0009] こうすることにより書き込み完了フラグを主記憶メモリに書き込む時間は必要となるが、電源遮断が起きた場合においても、電源遮断後の電源投入時にこの管理領域中の書き込み完了フラグが書き込まれているかどうかで、データの書き込みが成功したか失敗したかを判別することができる。書き込み完了フラグが立てられたページを含むクラスタ又はブロックについては、確実なデータが記録されたものとして取り扱うことができ、信頼性が向上する。(特許文献1参照)

特許文献1:特開2003-15929号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0010] さて最近、1つのメモリセルで2を超える論理状態をとることができるメモリセル、即ち 多値のフラッシュメモリとして、多値のNANDフラッシュメモリが注目されている。多値 のフラッシュメモリは低コストで大容量化できる品種であるが、書き込み単位であるペ 一ジに対して分割書き込みができない。即ちページのある領域部分にデータを書き 込んだ後に、消去することなく同一ページの別の領域にデータを書き込むことができ ない。このような制約があるため、主記憶メモリに多値のNANDフラッシュメモリを用 いると、従来のようにデータを書き込んだ後に、書き込んだページの管理領域に書き 込み完工フラグを書き込れてとかできない。
- [0011] 書き込み完了フラグを書き込まなければ書き込み速度が速くなるが、信頼性が低下 することとなり、このため電源遮断対策が困難になる。従って信頼性を確保するため には、データの書き込み先とは異なる物理領域に書き込み完了フラグ領域を設けて 、そこに書き込み完了フラグを書き込む必要がある。
- [0012] しかし、別の物理領域を設けるとすると、主記憶メモリの容量として512MB(バイト) を使用する場合、数式(1)により32k個の書き込み完了フラグを書き込める領域を確保する必要がある。

512MB÷16kB=32k個···(1)

しかし、書き込み単位であるページの分割書き込みができないので、書き込み完了 フラグを1ビットとしても、その1ビット用に1ページ(2kB)分の容量を確保する必要が ある。従って、数式(2)により書き込み完了フラグ用に充てる物理ブロックの容量は6 4MBとなる。

32k個×2kB=64MB···(2)

そのため主記憶メモリにおいてデータを記憶させるための使用可能領域が大幅に減ってしまうという問題が生じる。

[0013] 本発明は、不揮発性メモリを主記憶メモリとし、分散型の管理方法を用いる半導体 メモリ装置において、信頼性を高く保ちつつ高速に書き込みができるようにすることを 解決すべき課題とする。

課題を解決するための手段

- [0014] 本発明による半導体メモリ装置は、第1の記憶容量のデータ領域とデータ管理領域から成る複数の記憶容量単位で構成された記憶領域を有する不揮発性の主記憶メモリと、前記主記憶メモリのアドレス管理情報を記憶するアドレス管理情報記憶部と、前記主記憶メモリに対して第2の記憶容量単位毎に設けられ、データ書き込みが完了したときに立てられる書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記憶する不揮発性の制御メモリと、ホストからデータ読み書き指示に応じて前記主記憶メモリに対してデータの読み書き制御を行うと共に、前記アドレス管理情報記憶部及び前記制御メモリの更新制御を行う制御部と、を備えたものである。
- [0015] ここで前記第2の記憶容量単位はクラスタサイズであり、前記制御メモリは、ホストのファイルシステムで規定されたクラスタサイズ毎に1ビット以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録するようにしてもよい。
- [0016] ここで前記第2の記憶容量単位はセクタサイズであり、前記制御メモリは、ホストのファイルシステムで規定されたセクタサイズ毎に1ビット以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録するようにしてもよい。
- [0017] 前記第2の記憶容量単位は物理ブロックサイズとし、前記制御メモリは、前記主記 憶メモリのN個(Nは1以上の整数)の物理ブロックの容量毎に1ビット以上の書き込 み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録するようにしてもよい。
- [0018] 前記制御メモリは、書き込み速度が前記主記憶メモリより速いものとしてもよい。
- [0019] 前記制御部は、予め記憶された第2の記憶容量単位に基づき、初期化時もしくは 工場出荷時に、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成するようにしてもよ い。
- [0020] 前記制御部は、ホストから転送された第2の記憶容量単位に基づき、初期化時もしくは工場出荷時に、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成するようにしてもよい。
- [0021] 前記主記憶メモリは、多値型のNANDフラッシュメモリとしてもよい。
- [0022] 前記アドレス管理情報記憶部は、前記主記憶メモリの記憶容量単位毎の状態を記

億する物理領域管理テーブルと、ホストのファイルシステムで規定されるアドレスと前 記主記憶メモリの記憶容量単位のアドレスを変換するアドレス変換テーブルとを有す るようにしてもよい。

[0023] ここで前記制御メモリは、強誘電体メモリ(FeRAM)、磁性記録式随時書き込み読み出しメモリ(MRAM)、オポニックユニファイドメモリ(OUM)、レジスタンスRAM(RRAM)としてもよい。

発明の効果

[0024] 本発明では主記憶メモリへのデータの書き込みに対応して、制御メモリに書き込み 完了フラグを書き込むようにした。そのため主記憶メモリへのデータ書き込み中に電 源遮断が起きても、その直後の電源投入時に制御メモリの対応する書き込み完了フ ラグの有無を調べることにより、電源遮断前にデータが正しく書き込めたかどうかを判 断することができる。また制御メモリは、1バイト単位以下での書き込み速度が主記憶 メモリより速い書き込み速度のメモリを用いることにより、従来の半導体メモリ装置より も高速な書き込み処理が実現できる。

図面の簡単な説明

- [0025] [図1]図1は従来の半導体メモリ装置の主記憶メモリの構成を示す図である。
  - [図2]図2は従来の主記憶メモリの物理ブロックの構成を示す図である。
  - [図3]図3は従来の1クラスタ分の書き込み及び書き換えを示したタイムチャートである
  - [図4]図4は本発明の実施の形態における半導体メモリ装置の全体構成図である。
  - [図5]図5は本実施の形態における物理ブロックの説明図である。
  - [図6]図6は本実施の形態における論理アドレスフォーマットの説明図である。
  - [図7]図7は本実施の形態における書き込み完了フラグテーブルの説明図である。
  - [図8]図8は本実施の形態におけるアドレス変換テーブルの説明図である。
  - [図9]図9は本実施の形態における物理管理領域テーブルの説明図である。
  - [図10]図10は本実施の形態における1クラスタ分の書き込み又は書き換えを示したタ イムチャートである。
  - [図11]図11は本実施の形態における1クラスタの分書き換え動作を示した説明図で

ある。

[図12]図12は他の実施の形態における書き込み完了フラグテーブルの説明図である。

符号の説明

#### [0026] 100 ホスト

- 102 制御部
- 103 RAM
- 104 ROM
- 105 書き込み完了フラグテーブル
- 106 制御メモリ
- 107 メモリアクセス部
- 108 アドレス変換テーブル
- 109 物理領域管理テーブル
- 110 アドレス管理情報記憶部
- 111 メモリコントローラ
- 112 主記憶メモリ

### 発明を実施するための最良の形態

- [0027] 本発明の実施の形態による半導体メモリ装置について、図面を参照しつつ説明する。図4は、本実施の形態における半導体メモリ装置の全体構成図である。半導体メモリ装置はメモリコントローラ111及び主記憶用の不揮発性メモリ(以下、単に主記憶メモリという)112により構成される。ホスト100は、メモリコントローラ111を介して主記憶メモリ112にユーザデータ(以下、データという)の読み書き命令及び読み書きアドレスとデータとを転送するアクセス装置である。メモリコントローラ111は、ホスト1/F101、制御部102、RAM103、ROM104、制御用不揮発性メモリ(以下、単に制御メモリという)106、メモリアクセス部107、アドレス管理情報記憶部110を含んで構成される。
- [0028] 次に主記憶メモリ112について説明する。この実施の形態においては、主記憶メモ リ112は4Gビット、即ち512Mバイトの容量を持つ。主記憶メモリ112は図1に示すよ

うに、複数の物理ブロック、例えばPBO~PB2047までの2048の物理ブロックによっ て構成される。各物理ブロックのデータ容量は256kB(バイト)とする。この主記憶メ モリ112は、多値のNANDフラッシュメモリとする。

- [0029] 図5は本実施の形態における物理プロックを示した説明図である。各物理プロックはページ0~ページ127までの128ページから構成される。各ページは、セクタ0~セクタ3までの4セクタのデータ領域と管理領域(MR)とから構成される。1セクタは512Bの容量を有し、各ページは2048Bの容量のデータ領域を有する。ここでは1ページ分のデータ容量単位を第1の容量単位とし、その容量単位に対応して管理領域を有する。管理領域は64Bの容量を有する。管理領域内にはそのデータの有効や無効を示す状態コード、誤り訂正のためのECCコードが含まれるが、書き込み完了フラグは含まれていない。この主記憶メモリ112は多値のNANDフラッシュメモリであるため、ページ単位でのみ書き込みが可能であり、ページ単位でのみ、又はセクタの一部の管理領域のみを独立して書き込むことができない。
- [0030] 図6は本実施の形態における論理アドレスフォーマットを示した説明図である。図6 において下位ビットから順に、セクタナンバー、ページナンバー、論理プロックナンバー (LBN)であり、論理プロックナンバーに対応する11ビット分がアドレス変換の対象、即ちアドレス変換テーブル108のアドレスに相当する。なおホスト100のファイルシステムで規定されるセクタサイズを512B、クラスタサイズを16kBとすると、クラスタナンバーのLSBは論理アドレスフォーマットのビットb5に対応する。
- [0031] 制御部102はメモリコントローラ111内の全体制御、ホスト100からのデータ読み書き指示に応じてメモリアクセス部107に対しデータの読み書き制御を行うと共に、アドレス管理情報記憶部110と制御メモリ106の更新制御を行うものであり、CPUを含んで構成される。RAM103は制御部102のワーク用のRAMである。ROM104は制御部102が実行するプログラムを格納したROMである。制御メモリ106は書き込み完了フラグテーブル105を記憶する不揮発性メモリである。制御メモリ106は、1ビット単位又は1バイト単位以下での書き込み速度が主記憶メモリ112より速いものであることが好ましい。制御メモリ106は、例えば強誘電体メモリ(FeRAM)、磁気記録式随時書込路出メモリ(MRAM)、オポニックユニファイドメモリ(OUM)、又はレジスタン

スRAM(RRAM)を用いることができる。ここでは制御メモリ106としてFeRAMを使用する。一般のフラッシュメモリと比較してFeRAMは、オーバーライトが可能、即ち 書換時に消去等が不要であり、少容量、例えば1ビット又は1パイト単位での書き込 み速度が速いという利点がある。

- [0032] 制御メモリ106の書き込み完了フラグテーブル105は、ホスト100が転送したデータを主配億メモリ112に書き込んだ直後に、対応する論理アドレスに書き込み完了フラグを書き込むためのテーブルである。
- [0033] 図7は本実施の形態における書き込み完了フラグテーブル105を示す説明図である。書き込み完了フラグは第2の記憶容量単位毎に立てられ、その単位への書き込みを示すものであり、図7は第2の記憶容量単位、ここでは1クラスタ(16kB)、即ち8ページ毎にフラグを書き込む場合を示す。即ち書き込み完了フラグがクラスタ単位で記録されているので、1つの論理ブロックに対応する書き込み完了フラグは2バイト分ある。この場合、書き込み完了フラグテーブル105、即ち制御メモリ106は4kBの容量である。32kクラスタ分の書き込み完了フラグ(1ビット)はバイトのからから順番にクラスタ順に配列させる。そして対応するグラスタのデータが主記憶メモリ112に書き込まれた直後に、対応するビットに値「1」を書き込むものとする。
- [0034] 次にメモリコントローラ111内のメモリアクセス部107は、主記憶メモリ112の読み書き及び消去制御を行うアクセス部である。
- [0035] 次にアドレス管理情報記憶部110は、アドレス変換テーブル108と物理領域管理テーブル109を一時記憶するメモリである。このメモリはRAM等の揮発性メモリでも不揮発性メモリでも良い。
- [0036] 図8は本実施の形態におけるアドレス変換テーブル108の説明図である。アドレス 変換テーブル108はホスト100が転送した論理アドレスを、主記憶メモリ112内の物 理アドレスに変換するテーブルである。図8において、そのアドレスはホスト100が指 定した論理アドレスの論理ブロックナンバー(LBN)に対応し、アドレス変換テーブル 108内には当該アドレスに対する物理ブロックナンバー(PBN)が記憶されている。
- [0037] 図9は本実施の形態における物理管理領域テーブル109の説明図である。物理領域管理テーブル109は主記憶メモリ112内の物理領域、例えば消去単位である物理

プロックの状態を記憶するテーブルである。物理プロックの状態とは、例えば有効データが書き込まれているどうか等を示すものである。図9において物理領域管理テーブル109のアドレスは、主記憶メモリ112の各物理プロックナンバーPSNに対応し、各物理プロックの状態を記憶する。2進数で値「00」は有効なデータが記憶されている有効プロックを示す。値「11」は消去済みプロック又はデータが書き込まれているが不要である無効プロックを示す。値「10」はメモリセル上のソリッドエラー等により使用できなくなった不良プロックを示す。

- [0038] まず、本半導体メモリ装置の出荷直後における主記憶メモリ112や各種テーブルの 内容について説明する。なお簡単のため、主記憶メモリ112内のシステム領域につ いては説明を省略し、通常領域、即ちユーザがデータを読み書きする領域について のみ説明する。制御部102は、ROM104や主記憶メモリ112等に予め記憶された所 定の記憶容量単位に基づき、初期化時もくは工場出荷時に、書き込み完了フラグ テーブルのメモリマップを構成する。この場合はクラスタ単位に図7に示すように書き 込み完了フラグテーブル105のメモリマップを構成する。初期化時若しくは工場出荷 時には、書き込み完了フラグテーブル105は全ビット、値「0」となっている。
- [0039] また主記憶メモリ112の良ブロックは全て消去された状態となっている。物理領域管理テーブル109の良ブロックは無効ブロック状態、2進数で「11」となり、初期不良ブロックは不良ブロック、2進数で「10」となっている。アドレス変換テーブル108は全ビット、値「0」となっている。因みにどんな値をとっても差し支えない。
- [0040] この半導体メモリ装置の動作について説明する。この実施の形態による半導体メモ リ装置は、分散型のアドレス管理方法をとるため、電源投入時には主記憶メモリ112 の各物理ブロックの管理領域に保持されている管理情報を読み出す。そしてアドレス 管理情報記憶部110に2つのテーブル108, 109を構成する。
- [0041] 次に、1クラスタの書き込み毎に書き込み完了フラグを記憶する場合について説明する。ホスト100からの読み書き等のコマンド受付状態に入った後、ホスト100から任意の論理アドレスへの書き込み指示がなされる。なお通常ホスト100はクラスタ単位で書き込む場合が多いので、以降クラスタ単位での書き込みについて説明する。
- [0042] 図10(A)は本実施の形態における1クラスタ分の書き込みを示したタイムチャート

である。ホスト100はメモリコントローラ111に任意のクラスタの書き込み指示及び対応する論理アドレスを転送する。ホスト100から任意のクラスタの書き込み命令が転送されると、そのクラスタが含まれる論理プロックに対応する2パイト分の書き込み完了フラグのビットをリセットし、値「0」とする。制御部102は物理領域管理テーブル10900番地側から降順に無効プロックをサーチし、最初に見つかった無効プロックを書き込み対象プロックとし、主記憶メモリ112のその物理プロックを消去した後に送られてきたデータを書き込む。この書き込み時間下11は数msである。

- [0043] 図10において主記憶メモリ112からフィードバックされるビジー信号(R/B信号)の 立ち上がりに基づき、一連の書き込み動作が完了した時刻t10の直後の時刻t2に、制 御部102は書き込み完了フラグテーブル105の対応するビットに値「1」を書き込む。 制御メモリ106にFeRAMを用いているので、この書き込み時間T12は100ns程度 である。
- [0044] 一方書き込み対象となるクラスタを含む論理プロックナンバーに対応する物理プロックが有効プロックとなっていれば、その論理プロックの他のページにデータが既に書き込まれていると判断する。図11は1クラスタ分の書き換えを示した説明図である。図11において、物理プロックPBiはページ0~ページ127に全てデータが書き込まれている物理プロックとする。この物理プロックPBiの1クラスタ分、ページ0~7を書き換える場合について説明する。物理プロックPBiは書き換えのために用意された新たな物理プロックであり、無効なデータが書き込まれている物理プロックとする。この場合には書き込む対象となる物理プロックPBiのページ0~7に1クラスタ分の新たなデータを書き込む。続いて既存の物理プロックPBiのページ8~127までの120ページ分を物理プロックPBiにコピーする。このとき書き込み完了フラグは、残りのページのコピーが必要か否かを制御部102が判断するために用いられる。
- [0045] 図10(B)においてT21は主記憶メモリ112のページ0~7への書き込み時間であり、これは例えば数m秒である。そしてこの終了後にページ8~127までの120ページ分のコピーを行う。この書き込み時間T22は例えば数十m秒である。制御部102は主記憶メモリ112からフィードバックされるビジー信号(R/B)の立上りに基づき、一連の書き込み動作が終了した時刻t3の直後の時刻t4に書き込み先了フラグを書き

込み完了フラグテーブル105に書き込む。この書き込み時間T23は100ns程度である。このフラグの書き込みは127ページ分の全ての物理ブロックに書き込みがなされているため、各クラスタに相当するビットに1を立てて書き込み完了フラグとする。

- [0046] 以上のように書き込み完了フラグテーブル105を不輝発性メモリ上に、クラスタに対応したビット配列にマッピングし、一連の書き込み動作が完了した後に書き込み完了フラグを書き込み完了フラグテーブル105に書き込むようにした。このため、データの書き込み中において電源遮断等が発生しても、電源遮断後の初期化時に制御部102が書き込み完了フラグテーブル105の内容を調べることにより、正常にデータが書かれたかどうかを判別することができる。
- [0047] 次に電源投入時に書き込み完了フラグを用いて書き込みの信頼性を確認する処理について説明する。まず制御部102は物理領域管理テーブル109を検索し、有効な物理プロックを調べる。そしてアドレス変換テーブル109より有効な物理プロックアドレスに対応する有効な論理プロックアドレスを検索する。次いで有効な論理プロック に対応する書き込み完了フラグテーブル105を調べる。このとき書き込み完了フラグ がクラスタ単位で記録されているので、1つの論理プロックに対応する書き込み完了フラグ がクラスタ単位で記録されているので、1つの論理プロックに対応する書き込み完了フラグは2バイト分ある。そこで上位のバイト(バイトの)から2バイトつつ論理プロックアドレスの、1、2・・・の順に書き込み完了フラグテーブル105を検索する。そして有効な論理プロックアドレスに対応する書き込み完了フラグテーブルの2バイトの組が全て「0」の場合には、その論理プロックはデータが書き込まれている最中に電源遮断が生じて正しくデータが書き込まれていない可能性があると判断する。この場合はその論理プロックは無効な論理プロックとする。即ちアドレス変換テーブル108に基づいて対応する物理プロックアドレスを調べ、物理領域管理テーブル109の物理プロックの状態を無効状態とする。
- [0048] こうすれば書き込み単位であるページに分割書き込みできない不揮発性メモリを主 記憶メモリ112として使用した場合においても、データとしての使用可能領域を大幅 に削減することなく、簡単な回路構成で信頼性の高い半導体メモリ装置を提供できる
- [0049] また書き込み完了フラグテーブル105を、FeRAMのような少容量(少なくとも1ビッ

- ト〜1バイト)での書き込み速度が速い不揮発性メモリに備えることとすれば、書き込み完了フラグの書き込み時間を短縮でき、全体の書き込み速度を向上させることができる。
- [0050] なお、本実施の形態においては、書き込み完了フラグを記録する第2の記憶容量 単位は図7に示すようにクラスタ単位としたが、図12に示すように物理ブロック(256k B)単位とし、この単位で書き込み完了フラグを書き込むようにしてもよい。また第2の 記憶容量単位をセクタ単位やページ単位としてこの単位で書き込み完了フラグを書 き込むようにしてもよい。
- [0051] また本実施の形態では、不揮発性の主記憶メモリ112として、多値のNANDフラッシュメモリを用いているが、主記憶メモリとして二値型のNANDフラッシュメモリやAG AND型フラッシュメモリを用いてもよい。又フラッシュメモリ以外の不揮発性メモリを用いてもよい。また主記憶メモリ112は、複数の不揮発性メモリチップを内蔵してもよい
- [0052] 本実施の形態では、予め記憶された記憶容量単位に基づき初期化時もしくは工場 出荷時に書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成している。これに代えて、 所定の記憶容量単位の値をホストが転送し、書き込み完了フラグテーブルの構成を 決定するようにしてもよい。 産業 上の利用可能性
- [0053] 本発明にかかる半導体メモリ装置は、特に大容量の不揮発性メモリを主記憶メモリ として用いたメモリ装置において、簡単な回路で高信頼性と高速処理化を図ることが できる。このため、半導体メモリ装置を使用した機器、例えば静止画記録再生装置や

動画記録再生装置、あるいは携帯電話等の種々の機器において有益である。

## 請求の範囲

第1の記憶容量のデータ領域と管理領域から成る複数の記憶容量単位で構成された記憶領域を有する不揮発性の主記儀メモリと.

前記主記憶メモリのアドレス管理情報を記憶するアドレス管理情報記憶部と、

前記主記憶メモリに対して第2の記憶容量単位毎に設けられ、データ書き込みが完 了したときに立てられる書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを 記憶する不揮祭件の制御メモリと

ホストからデータ読み書き指示に応じて前記主記憶メモリに対してデータの読み書き制御を行うと共に、前記アドレス管理情報記憶部及び前記制御メモリの更新制御を行う制御部と、を備えた半導体メモリ装置。

[2] 前記第2の記憶容量単位はクラスタサイズであり、

前記制御メモリは、ホストのファイルシステムで規定されたクラスタサイズ毎に1ビット 以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録する請求項 1記載の半導体メモリ装置。

- [3] 前記第2の記憶容量単位はセクタサイズであり、
  - 前記制御メモリは、ホストのファイルシステムで規定されたセクタサイズ毎に1ビット 以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録する請求項 1記載の半導体メモリ装置。
- [4] 前記第2の記憶容量単位は物理ブロックサイズとし、

前記制御メモリは、前記主記憶メモリのN個(Nは1以上の整数)の物理ブロックの 容量毎に1ビット以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを 記録する請求項1記載の半導体メモリ装置。

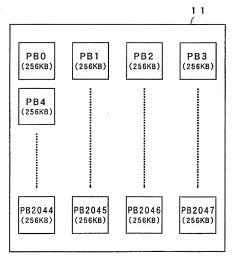
- [5] 前記制御メモリは、書き込み速度が前記主記憶メモリより速い請求項1記載の半導体メモリ装置。
- [6] 前記制御部は、予め記憶された第2の記憶容量単位に基づき、初期化時もしくは 工場出荷時に、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成する請求項1記載 の半導体メモリ装置。
- [7] 前記制御部は、ホストから転送された第2の記憶容量単位に基づき、初期化時もし

くは工場出荷時に、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成する請求項1 記載の半道体メモリ装備。

- [8] 前記主記憶メモリは、多値型のNANDフラッシュメモリである請求項1記載の半導体メモリ装置。
- [9] 前記アドレス管理情報記憶部は、前記主記憶メモリの記憶容量単位毎の状態を記憶する物理領域管理テーブルと、ホストのファイルシステムで規定されるアドレスと前記主記憶メモリの記憶容量単位のアドレスを変換するアドレス変換テーブルとを有する請求項1記載の半導体メモリ装置。
- [10] 前記制御メモリは、強誘電体メモリ(FeRAM)である請求項1記載の半導体メモリ装 置。
- [11] 前記制御メモリは、磁性記録式随時書き込み読み出しメモリ(MRAM)である請求 項1記載の半導体メモリ装置。
- [12] 前記制御メモリは、オポニックユニファイドメモリ(OUM)である請求項1記載の半導体メモリ装置。
- [13] 前記制御メモリは、レジスタンスRAM(RRAM)である請求項1記載の半導体メモリ 装置。

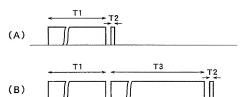
## 要約書

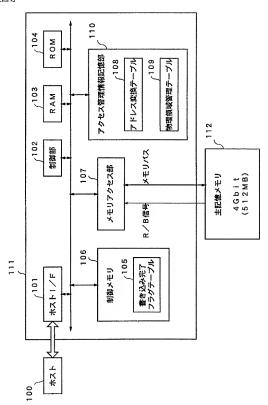
クラスタ又は物理ブロック等の所定の記憶単位に対応した書き込み完了フラグを記憶する書き込み完了フラグテーブル105を不揮発性の制御メモリ106に格納する。そして所定の記憶単位へのデータ書き込みが完了したことを検出し、書き込み完了フラグテーブル105上の対応する記憶単位のアドレスに書き込み完了フラグを書き込む。こうすればデータが正常に書き込まれたことが確認できる。主記憶メモリの書き込み単位のページに書き込みの完了を示すフラグを書き込めない場合も書き込みの信頼性を向上できる。



ページ0	0	1	2	3	МR
ページ1	0	1	2	3	MR
ベージ126	0	1	2	3	MR
ページ127	0	1	2	3	MR

[図3]



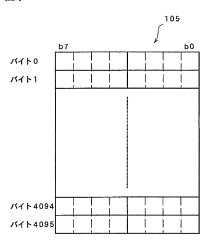


[図5]

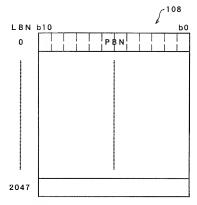
ページ0	0	1	2	3	MR
ベージ1	0	1	2	3	MR
			***************************************		
ベージ126	0	1	2	3	MR
ページ127	0	1	2	3	МR



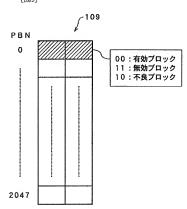
[図7]



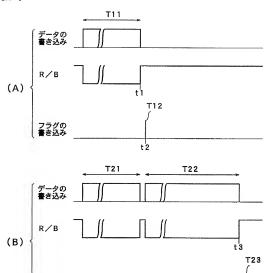
[図8]



[図9]

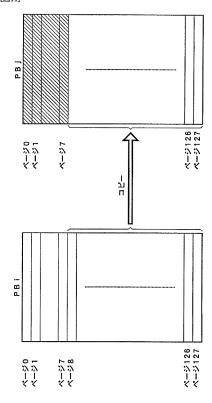






t 4

[図11]



[図12]

	b7					b0
パイトロ						
バイト1						
				 I		
パイト254						
バイト255						

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

## 代理人選任証

2004年9月22日

弁理士 岡本 宜喜 殿

名 称 松下電器 産業株式会社 あて名 甲571-8501 日本国大阪府門真市大字門真1006番地 代表者 中 村 邦 夫

すべての国際出願に関する手続きについて、貴級を代理人に選任したことに相違ありません。

## 特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (関四子偏寒脊機関)

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章) の 送付の通知書

> (法施行規則第57条) [PCT規則 71.1]

T 577-0066

P37427-P0

日本国大阪府東大阪市高井田本通7-7-19昌 利ビル安田岡本特許事務所内

出版人又は代理人 の書類記号

発送日 (日,月,年)

02, 05, 2006

重要な通知

国際出版系导 国際出際日 優先日 PCT/IP2005/003136 (日.月.年) 25,02,2005 (日.月.年) 27.02.2004

出願人 (氏名又は名称) 松下電器產業株式会社

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して特許性に関する国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、そ れらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務 局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備報告(付属書類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それをそ の選択官庁に送付する。

#### 4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと違く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内 手数料の支払い)をしなければならない (PCT39条 (1)) (様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付 された注を参照)。

国際出類の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、特許性に関する国際予備報告の付属書類の翻訳文を 含まなければならない。この翻訳文を作成し、関係する遊択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第日巻を参照すること。

出願人はPCT第33条(5)に注意する。すなわち、PCT第33条(2)から(4)までに規定する新規性、進歩性及び産業 上利用可能性の基準は国際予備審査にのみ用いるものであり、締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において 特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、追加の又は異なる基準を適用することができる (PCT第27条(5)も併せて参照)。そのような追加の基準は、例えば、実施可能要件や特許請求の範囲の明確性又は裏 付け要件を、特許要件から免除することも含む。

名称及びあて名 日本国特許庁 (IPEA/JP)	権限のある職員	5 M	8320
郵便番号100-8915	特 許 庁 長 官 電話番号 03-3581-1101 内線	3 5	99

## 特許協力条約

#### 発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

代那人 岡本官喜 様

あて名 〒577-0066

日本国大阪府東大阪市高井田本通7-7-19日利 ビル安田岡本特許事務所内

PCT 国際予備審査機關の見解書 (法第13条) [PCT規則66]

粉镁日 (日,月,年)

14, 02, 2006

出額人又は代理人

の書類記号 P37427-P0

店客期間

上記発送日から 2 月 人旦 以内

国際出願番号 国際出版日 優先日 PCT/IP2005/003136 (日.月.年) 25.02.2005

(日,月,年) 27,02,2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl. G06F12/16 (2006, 01)

出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社

- ▼ 国際調査機関の作成した見解書は、国際予備審査機関の世紀書と ▼ みなされる。 みなされない。
- 2. 2 回目の見解書は、次の内容を含む。

第1欄 見解の基礎

F 第日欄 修先権

第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

□ 第IV欄 発明の単一性の欠如

▽ 第V欄 法第13条(PCT規則66.2(a)(ii))に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につい ての見解、それを裏付けるための文献及び説明

□ 第VI標 ある種の引用文献

第14期 国際出版の不備

第四欄 国際出願に対する意見

3. 出願人は、この見解書に応答することが求められる。

いつ? 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出願人は、法第 13 条 (PCT規則 66.2(e))に規定するとおり、その期間の経過前に国際予備審査機関に期間延長を請求することができる。 ただし、期間延長が認められるのは含理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られる ことに注意されたい。

どのように? 法第13条 (PCT規則66.3) の規定に従い、答弁書及び必要な場合には、補正書を提出する。補正書の 株式及び言語については、法施行規則第62条(PCT規則66.8及び66.9)を参照すること。

なお 補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2(PCT規則66.4)を参照すること。

補正書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。審査官と の非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。

応答がないときは、国際予備審査報告は、この見解書に基づき作成される。 特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第2章)作成の最終期限は、

PCT規則 69.2 の規定により 27. 06. 2006

名称及びあて先 日本園特許庁(IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 5N 8320
郵便番号100-8915	丹治 彰
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3586

第1権	見解の基礎			
. ~	SELFERI TO DIATE	きは以下のものに基づき作成	1 %	
1. K			UE,	
ŗ		次の目的のための言語であ	ス 2五1・	「翻訳された、この国際出願の翻訳文
,		T規則 12.3(a)、23.1(b))	2	一個のこれに、こりが開発は確切が研究人
	•	T 規則 12. 4(a))		
	国際予備審査	(PCT規則 55.2(a) 又は 55	.3(a))	
2. =	の見解書は下記の出題	書類に基づいて作成された	(法第6条 (PCT14	条) の規定に基づく命令に応答するため
		tは、この見解書において「		
	Market - Francisco	n.40*		
Γ.	出版時の国際出版書	<b>/</b> 類		
V	明細衛			
	405	.4 55	dissipate entropy de la de de de com	
	第1-12		出願時に提出されたもの	) 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	96 96	ベージ		付けで国際予備審査機関が受理したもの
		- '		1777 TEEDIN 2 FOR MILESCHOOL SCHOOL STATE
V	請求の範囲			
	$\mathfrak{F}_{2, 3, 5-1}$		出願時に提出されたもの	
	第 1		PCT19条の規定に基へ	
	30		03. 6. 2005	付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
				1777 CELLON TOWN MEMORIAN SAME OF LOS
V	図面			
	第1-12		出願時に提出されたも	
	R_	ページ/図		付けで国際予備審査機関が受理したもの
	915	ページ/図		付けで国際予備審査機関が受理したもの
Γ.	配列表又は関連する	テーブル		
	配列表に関する	補充欄を参照すること。		
3. 🔽	補正により、下記の	書類が削除された。		
	厂 明細書	第		<b>ニ</b> ジ
	<ul><li>請求の範囲</li><li>図面</li></ul>	第4	I	
		に記載すること)		ページ/図
		るテーブル (具体的に記載・	すること)	WW.
_				
4.				Bを超えてされたものと認められるので、
	ての相上かされなか	ったものとして作成した。	(PCT規則70,2(e))	
	□ 明細書	38		ベージ
	「 請求の範囲	第		項
	図面	第		ベージ/図
		に記載すること)	L-7 - 1.	
	1 配列表に設建す	るテーブル(具体的に記載す	1028)	

第V橋	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第13条(PCT規則66.2(a)(ii)) それを裏付る文献及び説明	に定める見解、
1.	見解	

新規性 (N) 請求の範囲 1-3,5-13

請求の範囲

進歩性(IS) 請求の範囲

請求の範囲 1-3,5-13

産業上の利用可能性 (IA) 請求の範囲 1-3,5-13 請求の範囲

2. 文献及75時期

文献1: JP 2001-5928 A (日立マクセル株式会社) 2001,01,12,全文、全図 (ファミリーなし)

文献 2: JP 2003-15929 A (松下電器産業株式会社) 2003, 01, 17, 全文, 全図

& US 2003-189860 A1 & EP 1403771 A1 & WO 03-3219 A1 & CA 2420986 A

& CN 1465012 T

請求の範囲1-3.5-13に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1 2 から進歩性を有さない。

文献1には、電気的に書き込みが可能で、かつ所定の単位でデータを記憶する不揮 発性のデータ記憶部が設けられるICカードにおいて、上位装置からデータアクセス のために指定される論理ブロックアドレスを、複数のフラッシュメモリから構成され るデータ記憶部のメモリ空間上の実際のアドレスである実ブロックアドレスに変換す るための第1のテーブルと、実ブロックアドレス内のデータの状能を管理するフラグ 情報を格納するための第2のテーブルとを格納する不揮発性メモリは、アクセスがE EPROMやフラッシュメモリに比べて高速であり、バイト単位でデータの書換が可 能なFRAMや、電池でバックアップされたSRAMを用いること、そして、所定ブ ロックのデータのデータ記憶部への転送が終了すると、第2のメモリのフラグ情報を 「00H」に設定されること、電源瞬断がフラッシュメモリの書き込み処理中に発生 した場合、ICカードの電源投入後の初期化処理において、書き込み中フラグの状態 を確認し、フラグがセットされている場合には、前回の処理でデータ書き込み中の処 理中断が起こったと判断することが開示されている。また、文献2には、不揮発性メ モリの制御方法であって、ブロックを上書きしている途中に、記憶装置の電源遮断や リセット命令などで強制的な中断が発生した場合でも、データの消去・書込を管理す るための無効化フラグと有効化フラグとを、不揮発性メモリを複数に分割した記憶容 量単位であるブロック単位に設けたものが記載されている。

#### 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

#### 第 V 欄の続き

(請求の範囲1)

上記文献1の「データ記憶部」、「第1のテーブル」、「マイコン」は、それぞれ、請求の範囲1の「不揮発性の主記憶メモリ」、「アドレス管理情報記憶部」、「制御部」に対応する。

そして、実ブロックアドレス内のデータの状態を管理するフラグ情報を、主記憶メモリの第1の記憶容量より小さい第2の記憶容量単位に設けることは、文献2の記載に基づいて、当業者が容易に想到しうるものと認める。

(請求の範囲2, 3)

書き込み完了フラグを設ける記憶容量単位を、いかにするかは、当業者の設計的事項 にすぎないものであって、その単位としてクラスタサイズ、セクタサイズを採用するこ とに格別の技術的困難性が存するものとも認められない。

(請求の範囲5)

制御メモリの書き込み速度が主記憶メモリより速いことは、上記の通り文献1に記載されている。

(請求の範囲6,7)

制御部が、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成する際に、予め記憶された第2の記憶容量単位、あるいはホストから転送された第2の記憶容量単位とすることは、当業者の設計的事項にすぎない。

(請求の範囲8,9)

主記憶メモリを多値型のNANDフラッシュメモリとすること自体に格別の困難性 が存するものとは認められない。また、アドレス変換テーブルを有することは、上記の 通り文献1に記載されている。

(請求の範囲11-13)

制御メモリとして、強誘電体メモリ、磁性記録式随時書き込み読み出しメモリ、オボニックユニファイドメモリ、レジスタンスRAMを採用することは、当業者の設計的事項にすぎない。

## 特許協力条約

#### PCT

### 特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規制第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出額人又は代理人



出額人又は代理人 の書類記号 P37427-P0	今後の手続きについては、様式PCT/	/ IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2005/003136	国際出願日 (日. 月. 年) 25. 02. 2005	優先日 (日.月.年) 27.02.2004
PCT/JP2005/003136 (任. 月. 年) 25. 02. 2005 (日. 月. 年) 27. 02. 2004 国際特許分類 (IPC) Int.Cl. <i>G06F12/16</i> (2006.01)		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		
法施行規則第57条 (PCT36条) a	D規定に従い送付する。	
3. この報告には次の附属物件も添付さ	れている。	ジからなる。
		帯示の範囲を超えた補正を含むものとこの
b. 「 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示す。 (実施細則第802 号参照)	ように、電子形式による配列表又は配列去	(電子媒体の種類、数を示す)。 そに関連するテーブルを含む。

4.	この国際す	「簡都食報告は、	次の内容を含む。

▼ 第1欄 国際予備審査報告の基礎

厂 第Ⅱ欄 優先権

第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

「 第IV欄 発明の単一性の欠如

▼ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付 けるための文献及び説明

第VI機 ある種の引用文献

「第VI欄 国際出願の不備

□ 第1個欄 国際出版に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 03.06.2005	国際予備審査報告を作成した日 20.04.2006		
名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員) 5 M	8320	
日本国特許庁(IPEA/JP)	丹治 彰		
郵便番号100~8915			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 38	9 9	

<b>1</b> 3	I欄	報告の基礎				
		に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
		出願時の言語による国際出願 出願時の言語から次の目的のための言語である語に翻訳された、この国際出願の翻訳文				
		国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))				
		- 国際公開 (PC T 規則12.4(a)) - 国際公開 (PC T 規則12.4(a)) - 国際子衛参変 (PC T 規則55.2(a)又は55.3(a))				
1 ( anox 1 ) 別報 ( L ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )						
	この報告は下紀の出願事類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)					
	Г	出際時の国際出願書類				
	₹	明細審				
		第 1-12 ページ、出願時に提出されたもの				
		第 ページ*、 付けで国際子偏審衰機関が受理したもの				
		第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	V	請求の範囲				
		第 2, 3, 5-13 項、出額時に提出されたもの				
		第 <u>項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの</u>				
		第 1 項* 03.6.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 項* 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	_					
	7	図商 第 <u>1-12</u> <del>ページ、</del> 図、 出願時に提出されたもの				
		第 ページ/図* 付けで開際予備案を機関が受理したもの				
		第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	Г	配列表义は関連するテーブル				
		配列表に関する補充欄を参照すること。				
	V	補正により、下記の書類が削除された。				
		- 明細書 第 ページ				
		明細書     第     ページ       請求の範囲     第 4     項				
		図面 第 ページ/図				
		配列表 (具体的に記載すること)				
		配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること)				
	Γ.	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))				
		明細書 第ページ				
		『 請求の範囲 第 項				
		第二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二				
		□ 配列表 (具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること)				
		・ 能力がに対理するノーノル(共体的に記載すること)				
4	4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。					

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明

•		E3 &	
1		兒角	

新規性 (N)	請求の範囲 1-3, 5-13	有
	請求の範囲	<b>A</b>
進歩性 (18)	請求の範囲	
	請求の範囲 1-3, 5-13	無
産業上の利用可能性(IA	) 請求の範囲 <u>1-3, 5-13</u>	
	Att -th an Art DIV	for

#### 2. 文献及び説明 (PCT規制 70.7)

文献1: JP 2001-5928 A (日立マクセル株式会社) 2001.01.12, 全文, 全図 (ファミリーなし)

文献 2 : JP 2003-15929 A (松下電器産業株式会社) 2003.01.17, 全文, 全図 & US 2003-189860 A1 & EP 1403771 A1 & WO 03-3219 A1 & CA 2420986 A & CN 1465012 T

請求の範囲1-3,5-13に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1、2から進歩性を有さない。

文献1には、電気的に書き込みが可能で、かつ所定の単位でデータを記憶する不描 祭性のデータ記憶部が設けられるICカードにおいて、上位装置からデータアクセス のために指定される論理ブロックアドレスを、複数のフラッシュメモリから構成され るデータ記憶部のメモリ空間上の実際のアドレスである実ブロックアドレスに変換 するための第1のテーブルと、実ブロックアドレス内のデータの状態を管理するフラ グ情報を格納するための第2のテーブルとを格納する不揮発性メモリは、アクセスが EEPROMやフラッシュメモリに比べて高速であり、バイト単位でデータの書換が 可能なFRAMや、電池でバックアップされたSRAMを用いること、そして、所定 ブロックのデータのデータ記憶部への転送が終了すると、第2のメモリのフラグ情報 を「OOH!に設定されること、電源瞬断がフラッシュメモリの書き込み処理中に発 生した場合、ICカードの電源投入後の初期化処理において、書き込み中フラグの状 態を確認し、フラグがセットされている場合には、前回の処理でデータ書き込み中の 処理中断が起こったと判断することが開示されている。また、文献2には、不揮発性 メモリの制御方法であって、ブロックを上書きしている途中に、記憶装置の電源遮断 やリセット命令などで強制的な中断が発生した場合でも、データの消去・書込を管理 するための無効化フラグと有効化フラグとを、不揮発性メモリを複数に分割した記憶 容量単位であるブロック単位に設けたものが記載されている。

#### 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

#### 第 V 棚の続き

(請求の範囲1)

上記文献1の「データ記憶部」、「第1のテーブル」、「マイコン」は、それぞれ、請求の範囲1の「不揮発性の主記憶メモリ」、「アドレス管理情報記憶部」、「制御部」に対応する。

そして、実ブロックアドレス内のデータの状態を管理するフラグ情報を、主記憶メモリの第1の記憶容量より小さい第2の記憶容量単位に設けることは、文献2の記載に基づいて、当業者が容易に想到しうるものと認める。

(請求の範囲2,3)

書き込み完了フラグを設ける記憶容量単位を、いかにするかは、当業者の設計的事項にすぎないものであって、その単位としてクラスタサイズ、セクタサイズを採用することに格別の技術的困難性が存するものとも認められない。

(請求の範囲5)

制御メモリの書き込み速度が主記憶メモリより速いことは、上記の通り文献1に記載されている。

(請求の範囲6,7)

制御部が、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成する際に、予め記憶された第2の記憶容量単位、あるいはホストから転送された第2の記憶容量単位とすることは、当業者の設計的事項にすぎない。

(請求の範囲8,9)

主記憶メモリを多値型のNANDフラッシュメモリとすること自体に格別の困難性が存するものとは認められない。また、アドレス変換テーブルを有することは、上記の通り文献1に記載されている。

(請求の範囲11-13)

制御メモリとして、強誘電体メモリ、磁性記録式随時書き込み読み出しメモリ、オボニックユニファイドメモリ、レジスタンスRAMを採用することは、当業者の設計的事項にすぎない。

#### Claim Amendment under Article 34

- (Amended) A semiconductor memory device comprising:
- 5 a non-volatile main storage memory including a storage region consisting of a plurality of storage capacity units which are composed of a data region in a first storage capacity and management region;

an address management information storage part for

storing address management information of said main storage
memory;

a non-volatile control memory for storing a writing completion flag table which is provided to said <a href="corresponding">corresponding</a> main storage memory every second storage capacity unit <a href="smaller than said first storage capacity">smaller than said first storage capacity</a> and consists of writing completion flags placed when data writing is completed; and

a control part for performing read/write control for said main storage memory in accordance with a direction of 20 data read/write from a host and for performing update control for said address management information storage part and said control memory.

## 4. (Cancelled)

#### 請求の範囲

[1] (補正後)第1の記憶容量のデータ領域と管理領域から成る複数の記憶容量単位 で構成された記憶領域を有する不揮発性の主記憶メモリと、

前記主記憶メモリのアドレス管理情報を記憶するアドレス管理情報記憶部と、

前記第1の配憶容量より小さい第2の配憶容量単位毎に設けられ、対応する前記 主配億メモリに対してデータの書き込みが完了したときに立てられる書き込み完了フ ラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記憶する不揮発性の制御メモリと、 ホストからデータ読み書き指示に応じて前記主記憶メモリに対してデータの読み書

き制御を行うと共に、前記アドレス管理情報配億部及び前記制御メモリの更新制御を 行う制御部と、を備えた半導体メモリ装置。

- [2] 前記第2の記憶容量単位はクラスタサイズであり、 前記制御メモリは、ホストのファイルシステムで規定されたクラスタサイズ毎に1ビット 以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録する請求項 1記載の半選体メモリ辞書。
- [3] 前記第2の配憶容量単位はセクタサイズであり、 前配制御メモリは、ホストのファイルシステムで規定されたセクタサイズ毎に1ビット 以上の書き込み完了フラグから成る書き込み完了フラグテーブルを記録する請求項 1記載の半導体メモリ装置。
- [4] (削除)
- [5] 前記制御メモリは、書き込み速度が前記主記憶メモリより連い請求項1記載の半導体メモリ装備。
- [6] 前記制御部は、予め記憶された第2の記憶容量単位に基づき、初期化時もしくは 工場出荷時に、書き込み完了フラグテーブルのメモリマップを構成する請求項1記载 の半導体メモリ装置。
- [7] 前記制御部は、ホストから転送された第2の記憶容量単位に基づき、初期化時もし



PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED

OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Article 31(7) and Rule 61.3)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

OKAMOTO, Yoshiki c/o YASUDA & OKAMOTO, Shori Building, 7-7-19, Takaidahondori, Higashi-Osaka shi Osaka

5770066 JAPON

Date of mailing (day/month/year) 06 October 2005 (06.10.2005)

Applicant's or agent's file reference P37427-P0

PCT/JP2005/003136

International application No.

International filing date (day/month/year)

IMPORTANT INFORMATION

Priority date (day/month/year) 27 February 2004 (27.02.2004)

Applicant

25 February 2005 (25.02.2005)

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al.

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

National: BG, CA, CN, CZ, DE, JP, KP, KR, MN, NO, PL, RO, RU, SK, SM, US

The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

AP: BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

EA: AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM

OA: BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG

National: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BR, BW, BY, BZ, CH, CO, CR, CU, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MW, MX, MZ, NA, NI, NZ, OM, PG, PH, PT, SC, SD, SE, SG, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

3. Since the election(s) was (were) made before the expiration of 19 months from the priority date, the applicant is reminded that the must enter the "national phase" before the expiration of 20 months from the priority date before each of the Offices Island above. This must be done by paying the national feet's and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 389(1)a), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international performancy report on parentability (Chapter II of the Pateut Cooperation Teasy) (Article 36/30)(b) and Rute 74.1)

Some Offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. See the Annex to Form PCT/B/301 and, for details about the applicable time limits, Office by Office, see the PCT Applicant's Guide, Volume II, National Chapters, the PCT Newsletter and the WIPO Internet site, updated regularly.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Yoshiko Kuwahara

Facsimile No +41 22 338 90 90

Facsimile No.+41 22 740 14 35



## PCT

## From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

FIRST NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES WHICH DO NOT APPLY THE 30 MONTH TIME LIMIT UNDER ARTICLE 22(1))

OKAMOTO, Yoshiki c/o YASUDA & OKAMOTO, Shori Building, 7-7-19, Takaidahondori, Higashi-Osaka shi Osaka

(PCT Rule 47.1(c))

Date of mailing (day/month/year) 29 September 2005 (29.09.2005) Takaidahondori, Higashi-Osaka shi Osaka 5770066 JAPON

Applicant's or agent's file reference P37427-P0

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP2005/003136 International filing date (day/month/year) 25 February 2005 (25.02.2005) Priority date (day/month/year) 27 February 2004 (27.02.2004)

Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

- ATTENTION: For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), does apply, please see Form PCT/IB/308(Second and Supplementary Notice) (to be issued promptly after the expiration of 28 months from the priority date).
- Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, does not apply, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below: 09 September 2006 (09.09.2005)

CH

In accordance with Rule 47.1(e-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

 The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, does not apply, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 936is.1:

LU. SE. TZ. UG. ZM

In accordance with Rule 47.1(c.bis/tii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated Office(s) listed above, and unless a demand for international preliminary examination has been filed before the expiration of 19 months from the priority date (see Article 39(1)), the applicable time limit for emering the national phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 20 MONTHS from the priority date.

In practice, time limits other than the 20-month time limit will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated Offices listed above. For regular updates on the applicable time limits (20 or 21 months, or other time limit), Office by Office, refer to the PCT Gazette, the PCT Newsletter and the PCT Applicant's Guide, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at http://www.wipo.im/pct/en/index.html.

It is the applicant's sole responsibility to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Yoshiko Kuwahara

Facsimile No.+41 22 338 90 90

Facsimile No.+41 22 740 14 35



# **PCT**

### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

EIREDITE COCKEDINAKON KANAMAK

NOTIFICATION CONCERNING TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL APPLICATION AS PUBLISHED OR REPUBLISHED

OKAMOTO, Yoshiki c/o YASUDA & OKAMOTO, Shori Building, 7-7-19, Takaidahondori, Higashi-Osaka shi Osaka 5770066 JAPON

Date of mailing (day/month/year)	
09 September 2005 (09.09.2005)	

Applicant's or agent's file reference P37427-P0 IMPORTANT NOTICE

International application No. International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year)

Priority date (day/month/year) 27 February 2004 (27.02.2004)

Applicant

PCT/JP2005/003136

25 February 2005 (25.02.2005)

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

The International Bureau transmits herewith the following documents:	
copy of the international application as published by the International Bureau No. WO 2005/083573	on 09 September 2005 (09.09.2005) under
copy of international application as republished by the International Bureau - No. WO  For an explanation as to the reason for this republication of the international or (88) (as the case may be) on the front page of the attached document.	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Yoshiko Kuwahara

Facsimile No.+4: 22 740 14 35

Facsimile No.+41 22 338 90 90